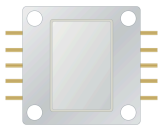
13400–14600 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 44.5 dBm (típico)

LCI-PA-13400-14600-PS44p5T · 13400–14600 MHz · GaN Amplificador de potência encapsulado.



Valores da tabela RF: PSAT 44.5 dBm (típico); Ganho de potência 19.5 dB (típico); PAE 32 % (típico). Condições de teste RF: TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 25 dBm; CW.

CMW017C

Aplicar a polarização de porta antes da de dreno. Ao desligar, remover primeiro a de dreno.

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 5

RFin: 3

Vd: 6, 10

RFout: 8

NC: 2, 4, 7, 9

Dimensões do encapsulamento: 15.25 × 15.25 × 1.4 mm.

Características RF

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 25 dBm; CW

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Frequência de operação	f	13400	-	14600	MHz
Potência de saída saturada	-	43.7	44.5	-	dBm
Ganho de potência	-	-	19.5	-	dB
Eficiência de potência adicionada	-	28	32	-	%
Planicidade do ganho de potência	-	-	-	±0.6	dB
Ganho de pequenos sinais	S21	-	28	-	dB

Polarização DC e correntes

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidade
Tensão de dreno	-	-	-	-	28	V
Tensão de porta	-	-	-	-	[-3.2, -2.4]	V

Valores limite

Valores limite; não são pontos de operação normal.

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Tensão dreno-fonte máxima	-	-	-	32	V
Polarização mínima da porta	-	-5	-	-	V
Temperatura de armazenamento	-	-65	-	150	°C
Potência de entrada máxima	-	-	-	28	dBm

Dimensões do encapsulamento

Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões do encapsulamento	15.25 × 15.25 × 1.4	mm

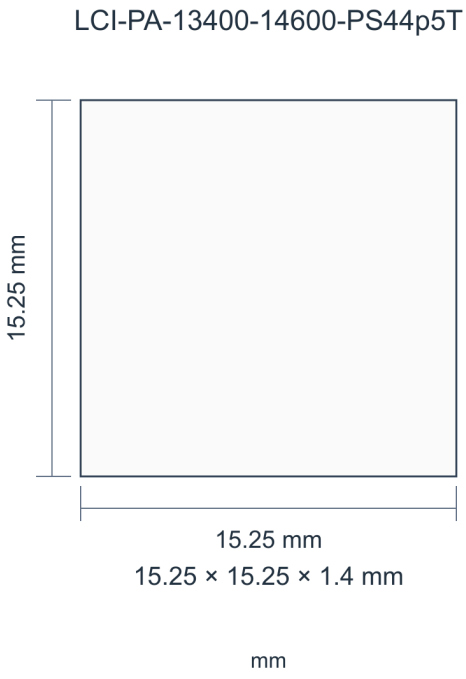
Registro da publicação atual · 1.8 · 2026-11-12. Atualização da descrição ou do conteúdo editorial. Substitui a revisão 1.7.

Notas de integração

CMW017C Aplicar a polarização de porta antes da de dreno. Ao desligar, remover primeiro a de dreno. Vg: C = 10 µF Vg: 1, 5 RFin: 3 Vd: 6, 10 RFout: 8 NC: 2, 4, 7, 9

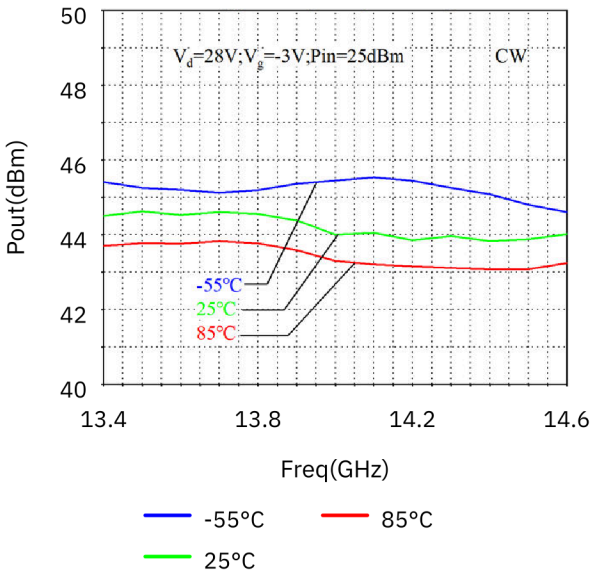
Desenho dimensional mecânico

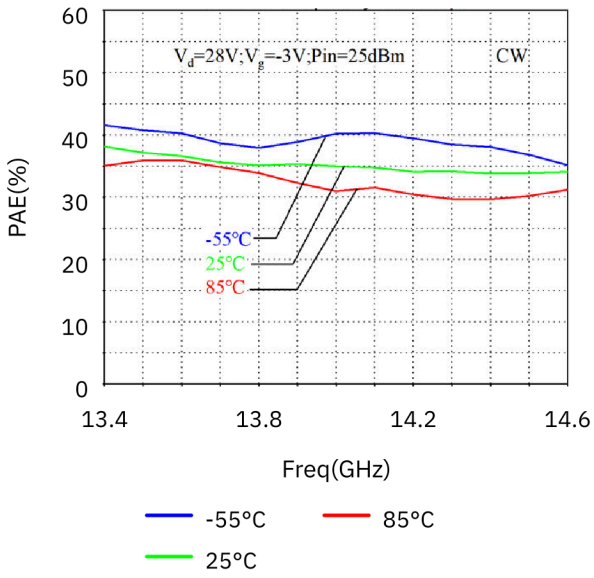
Desenho parcial com as dimensões confirmadas em mm. Para a instalação, consulte o desenho completo de instalação.

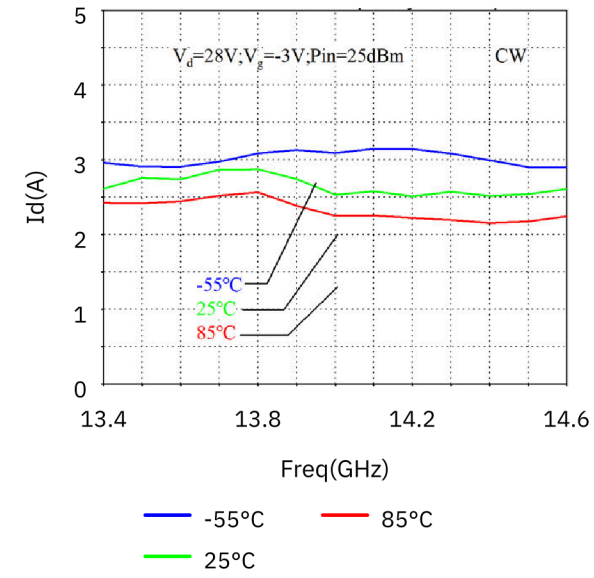


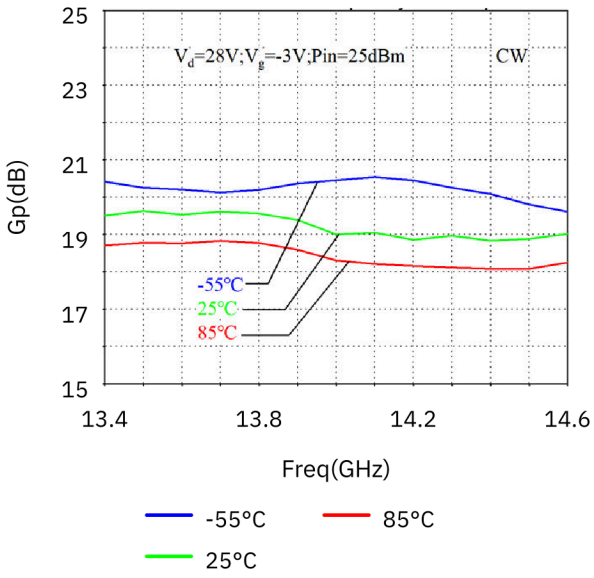
Curvas de desempenho

Cada gráfico de desempenho corresponde às condições de operação indicadas na figura.

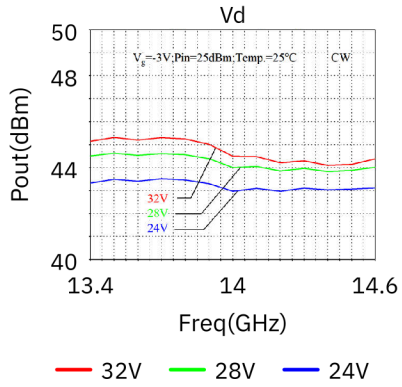


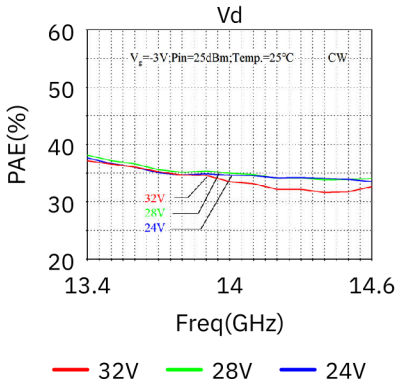


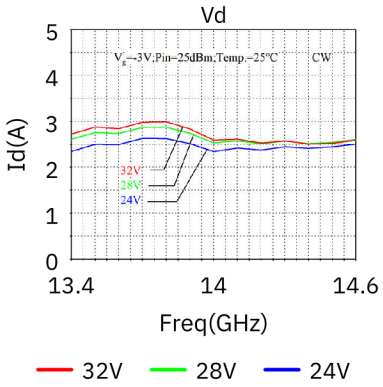


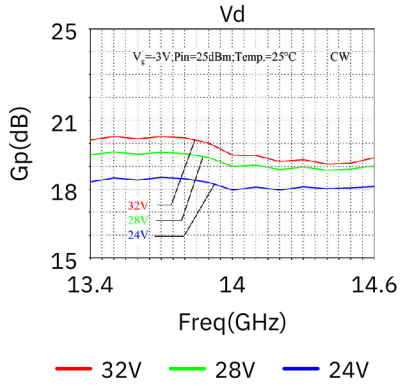


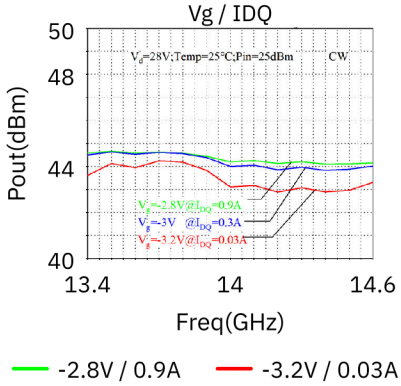
Potência de saída; Eficiência de potência adicionada; Corrente de dreno; Ganho de potência. Vd = 28 V; Vg = -3 V; Pin = 25 dBm; CW; T = -55/25/85 °C.

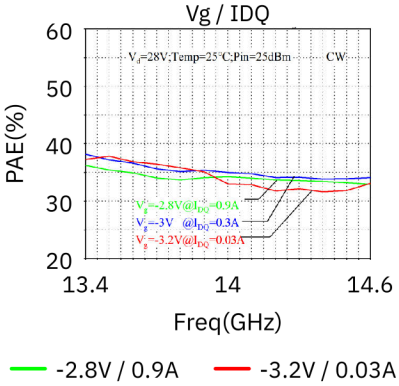


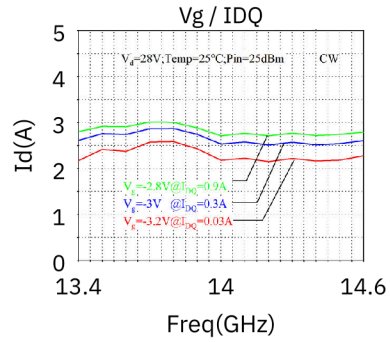


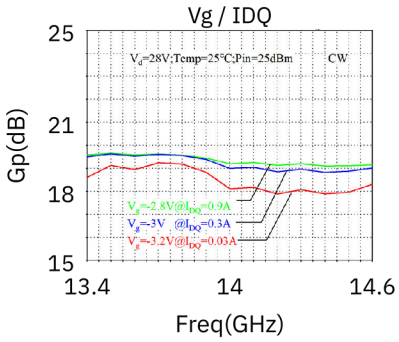




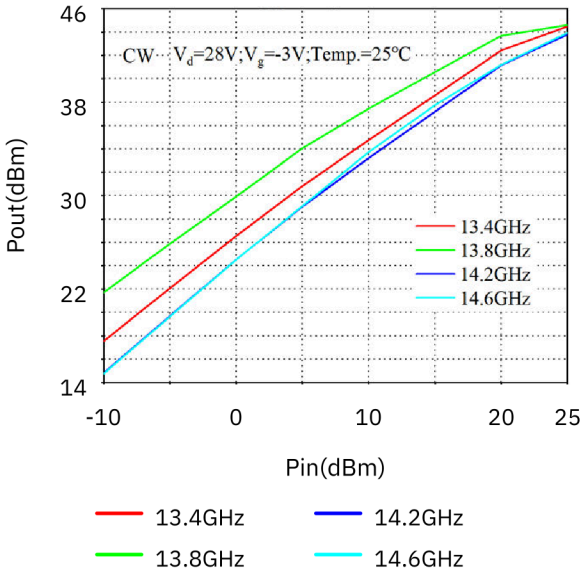


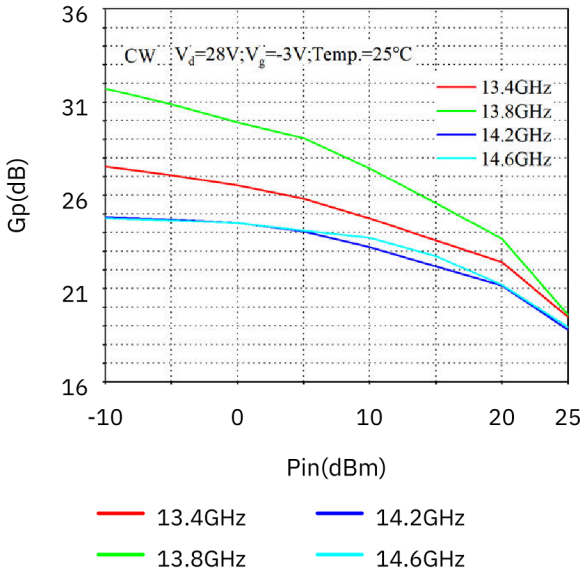


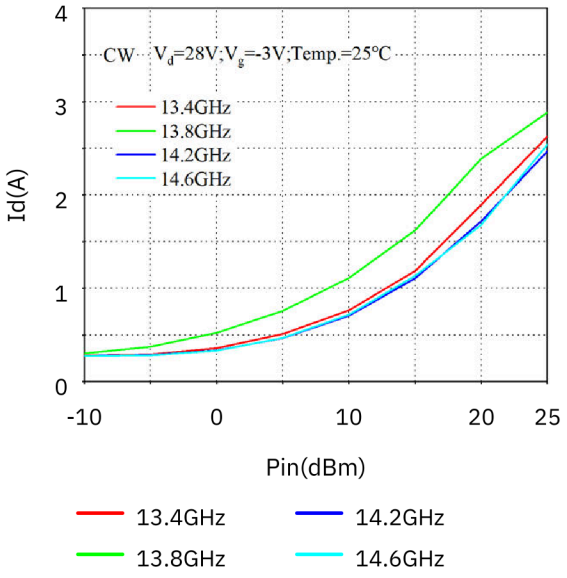




Potência de saída; Eficiência de potência adicionada; Corrente de dreno; Ganho de potência. CW; TA = 25 °C; Pin = 25 dBm. Gráficos 1–4: Vg = -3 V; Vd = 32/28/24 V. Gráficos 5–8: Vd = 28 V; Vg = -2.8 V/IDQ = 0.9 A, -3 V/IDQ = 0.3 A, -3.2 V/IDQ = 0.03 A. O ganho de potência Gp é expresso em dB.







Pout(dBm); Gp(dB); Id(A). CW; Vd = 28 V; Vg = -3 V; TA = 25 °C; Pin = -10...25 dBm; f = 13.4/13.8/14.2/14.6 GHz.

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.